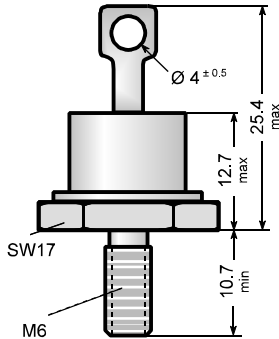


**Silicon-Power Rectifiers**
**Silizium-Leistungs-Gleichrichter**


Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	35 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Metal case – Metallgehäuse	DO-5
Weight approx. – Gewicht ca.	6 g
Recommended mounting torque Empfohlenes Anzugsdrehmoment	26 ± 10% lb.in. 3 ± 10% Nm

Standard: Cathode to stud / am Gewinde

Index R: Anode to stud / am Gewinde (e.g. 1N 1183 R)

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
1N 1183 = PBY 301	50	60
1N 1184 = PBY 302	100	120
1N 1186 = PBY 303	200	240
1N 1188 = PBY 304	400	480
1N 1190 = PBY 305	600	720
1N 3766 = PBY 306	800	1000
1N 3768 = PBY 307	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100/C$	$I_{FAV}$	35 A <sup>1)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	80 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25/C$	$I_{FSM}$	450 A
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25/C$	$I_{FSM}$	500 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25/C$	$i^2t$	1000 A <sup>2</sup> s

<sup>1)</sup> Valid, if the temp. of the stud is kept to 100/C – Gültig, wenn die Temp. am Gewinde auf 100/C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur

$T_j$  – 65...+175/C  
 $T_s$  – 65...+175/C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25/C$	$I_F = 100 A$	$V_F$	< 1.5 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25/C$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 500 : A
Thermal resistance junction to stud Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			$R_{thC}$	< 1 K/W

